Declaration a Power of Attorney For Patent polication

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD
	OF MANUFACTURING THE SAME
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□ _月_日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号をとし、(該当する場合)に訂正されました。	was filed on <u>August 6, 1999</u> as United States Application Number or PCT International Application Number 09/369, 158 and was amended on (if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第 37 編第 1 条 56 項に定義されると おり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of

があることを認めます。

Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第35編 119条(a)-rd)項スは365条(b)項 I hereby claim foreign priority under Title 35, United に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定して States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign いる持許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) 特許出願もしくは発明者証の出頭についての外国優先権を of any PCT International application which designated at ここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前 least one country other than the United States, listed に出頭された特許または発明者証の外国出頭を以下に、枠 below and have also identified below, by checking the

Prior Foreign Application(s)		certificate, or PCT International app date before that of the application claimed.	
外国での先行出類			選九 催土 武なし
10-225067	Japan_	August 7, 1998	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出題年月日)	
10-225070	Japan	August 7, 1998	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出額年月日)	
10-255497	Japan	September 9, 1998	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
	Japan (Country) (国名)	September 9, 1998 (Day/Month/Year Filed) (出頭年月日)	
10-255495	Japan	September 9, 1998	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出題年月日)	
10-255494	Japan	September 9, 1998	
(Number) /	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出題年月日)	
私は、第 35 編米国法典 119 条(e)兵 特許出願規定に記載された権利をここ		I hereby claim the benefit under Titl Code, Section 119(e) of any United application(s) listed below.	
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出願番号)	(出顧日)	(出題番号)	(出頭日)

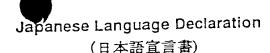
私は、下記の米国法典第 35 編 120 条に基いて下記の米 国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特 許協力条約 365 条(c)に基く権利をここに主張します。また、 本出願の各請求範囲の内容が米国法典代 35 編 112 条第 1 項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許 出願に開示されていない限り、その先行米国出願提出日以 降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日ま での期間中に入手された、連邦規制法典第 37 編 1 条 56 項 で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について 開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出題番号)	(出題日)	(現识:特許許可済、維続中、放棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出願番号)	(出類日)	(現況: 特許許可済、凝統中、故棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出頭교육)	(出類日)	(現況: 特許許可済、継続中、故棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出頭番号)	(出頭日)	(現況:特許許可済、継続中、放棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出頭番号)	(出瀬日)	(現況:特許許可済、継続中、放棄済)	
(Application No.) (Filing Date (出題番号) (出題日)		(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現记:特許許可済、継続中、放棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出額番号)	(出類日)	(現況:特許許可済、継続中、放棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出題番号)	(出額日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)	

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 福第 1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出頭した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.





米持許商源局に対して遂行する弁護士または代理人として、下記の 者を治名いたします。(弁護士、または代理人の氏名及び登録番号 を明記のこと)

委任状: 私は下記の発明者として、本出頭に関する一切の手続きを POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration

> Daniel W. Sixbey, (Reg. No. 20,932) Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26,477) David S. Safran (Reg. No. 27,997) Donald R. Studebaker (Reg. No. 32,815) Tim L Brackett (Reg. No. 36,092) Frank P. Presta (Reg. No. 19,828) Robert M. Schulman (Reg. No. 31, 196) Lawrence D. Eisen (Reg. No. 41,009)

Stuart J. Friedman (Reg. No. 24,312) Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23,016) Thomas W. Cole (Reg. No. 28,290) Jeffrey L Costellia (Reg. No. 35,483) Eric J. Robinson (Reg. No. 38,285) Joseph S. Presta (Reg. No. 35,329) Thomas M. Blasey (Reg. No. 33,475) Daniel S. Song (Reg. No. 43,143)

ここに署名する者は、この申請に関して米国特許商標局においてな されるべき如何なる行動に関しても、ここに指名された米国弁護士ま たは代理人が、米国弁護士または代理人とここに署名した者との間で 直接の連絡を取ることなしに、

からの指示を受け入れてそれに従う権限を与える。指示を出す人物 に変更がある場合は、ここに指名された米国弁護士または代理人 は、ここに署名した者からその旨通知を受ける。

The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U.S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

書類送付先

Send Correspondence to:

Sixbey, Friedman, Leedom & Ferguson 8180 Greensboro Dr., Suite 800 McLean, VA 22102

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Eric J. Robinson 703-790-9110

唯一または第一発明者		Full name of sole or first inventor	
		Hisashi OHTANI	
発明者の著名	日付	Inventor's signature	Date
		Hisashi Oktani	09/28/99
住所		Residence	
		Kanagawa, Japan	
国籍		Citizenship	
		Japanese	
私書箱		Post Office Address	
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY L	ABORATORY CO., LTD.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kan	nagawa-ken 243-0036
		Japan	





Tamae TAKANO Tamae TAKANO Tamae Takano Tamae Takano Alamae Takano Residence Kanagawa, Japan
Tamae Takano 09/28/99 Residence
Tamae Takano 09/28/99 Residence
Residence
Kanagawa Tanan
Citizenship
Japanese Post Office Address
, oat Office Address
c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036
Full name of third joint inventor, if any
Shunpei YAMAZAKI
Inventor's signature Date
Résidence July 99
Residence
Tokyo, Japan
Citizenship
Japanese
Post Office Address
c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036
Japan Japan
Full name of fourth joint inventor, if any
inventor's signature Date
Residence
Citizenship
Post Office Address